



No.967

2222

# STK8250

厚膜混成集積回路  
50W min AF パワーアンプ出力段 (2電源)  
類似 A バイアス回路内蔵



- 特長
- ・ B クラスアンプ不可避のスイッチングひずみをゼロとしている。
  - ・ パワー段とバイアスコントロール回路 および 温度補償回路は 熱結合の良好にして組み込まれているため サーミスタ等の複雑な温度補正は必要なく 熱的に安定動作が保証されている。
  - ・ バイアス電流の設定を外部にて行なうことにより 最適な条件設定ができる。

最大定格 /  $T_a = 25^\circ\text{C}$

最大電源電圧	$V_{CC \text{ max}}$		unit
熱抵抗	$\theta_{j-c}$	理想放熱状態	$1.8^\circ\text{C/W}$
コレクタ電流	$I_C$		5 A
接合部温度	$T_j$		$150^\circ\text{C}$
保存周囲温度	$T_{stg}$		$-30 \sim +105^\circ\text{C}$
負荷短絡許容時間	$t_b$	$V_{CC} = \pm 38\text{V}^{\ast\ast}, f = 50\text{kHz}, P_o = 50\text{W}, R_L = 8\Omega$	2 sec

推奨動作条件 /  $T_a = 25^\circ\text{C}$

推奨電源電圧	$V_{CC}$		unit
負荷抵抗	$R_L$		8 $\Omega$

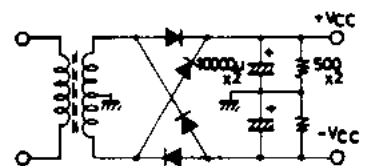
動作特性 /  $T_a = 25^\circ\text{C}, V_{CC} = \pm 38\text{V}, R_L = 8\Omega, R_g = 600\Omega, VG = 26\text{dB}$ , 指定測定回路 (応用回路例に準ずる) において。

		min	typ	max	unit
無信号電流	$I_{cc0}$			80	mA
出力電力	$P_o$		50		W
全帯調波ひずみ率	THD			0.01	%

$V_{CC} = \pm 43\text{V}^{\ast\ast}$   
 $\text{THD} = 0.01\%, f = 20\text{Hz} \sim 20\text{kHz}$   
 $P_o = 1.0 \sim 50\text{W}, f = 20\text{Hz} \sim 20\text{kHz}$

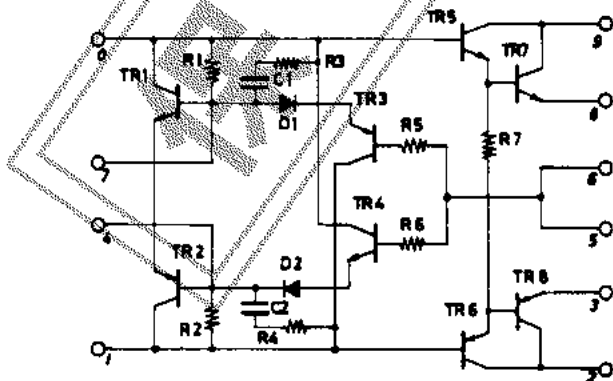
※：負荷短絡許容時間は右図の指定トランス電源を使用する。

※※：指定回路 VR1 (30k $\Omega$ ) 抵抗値最大とする。

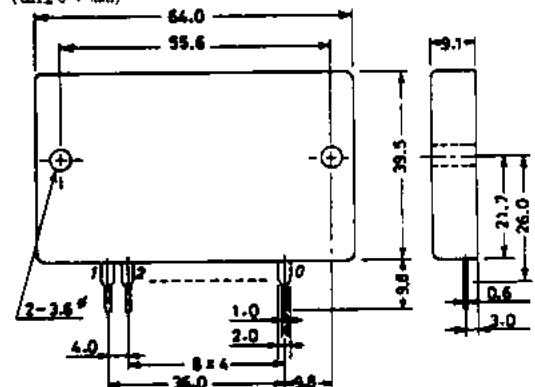


指定トランス電源 (タンゴMG-200相当)

等価回路



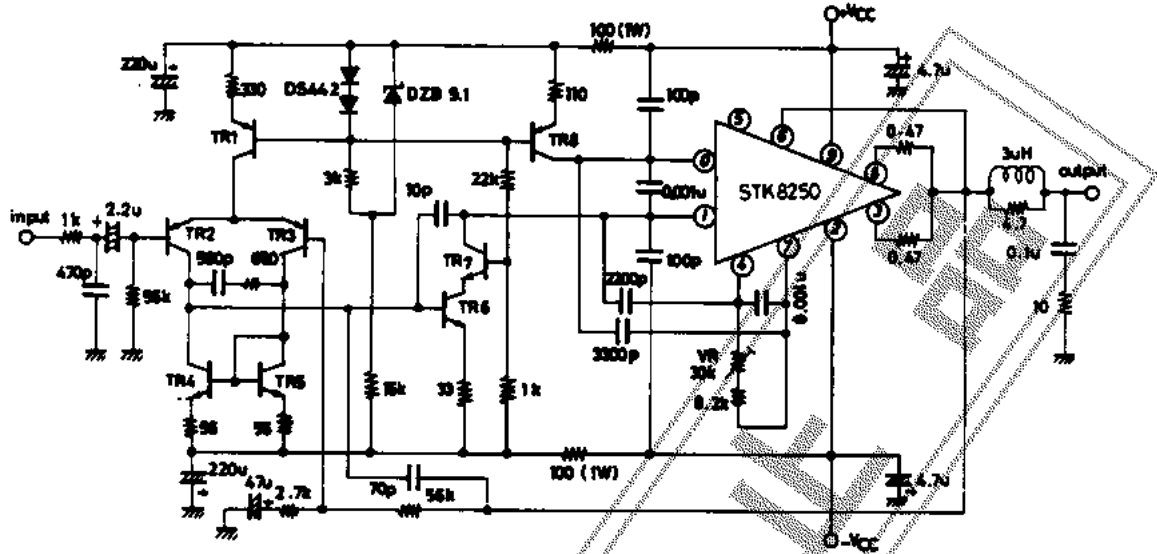
外形図 4006 (unit: mm)



※ これらの仕様は、改良などのため予告なく変更することがあります。

# STK8250

## ■ 応用回路例 : 50 W min AP パワーアンプ



### ■ 特許の非保証について：

この資料は正確かつ信頼すべきものであると確信しております。ただしその使用にあたって、工業所有権その他の権利の実施に対する保証、または実施権の許諾を行なうものではありません。

Information furnished by SANYO is believed to be accurate and reliable. However, no responsibility is assumed by SANYO for its use; nor for any infringements of patents or other rights of third parties which may result from its use, and no license is granted by implication or otherwise under any patent or patent rights of SANYO.

保 障